

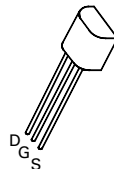
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ZVP2120A

ISSUE 2 – MARCH 94

FEATURES

- * 200 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)}=25\Omega$



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Drain-Source Voltage | V_{DS} | -200 | V |
| Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | I_D | -120 | mA |
| Pulsed Drain Current | I_{DM} | -1.2 | A |
| Gate Source Voltage | V_{GS} | ± 20 | V |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | P_{tot} | 700 | mW |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | $^{\circ}C$ |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

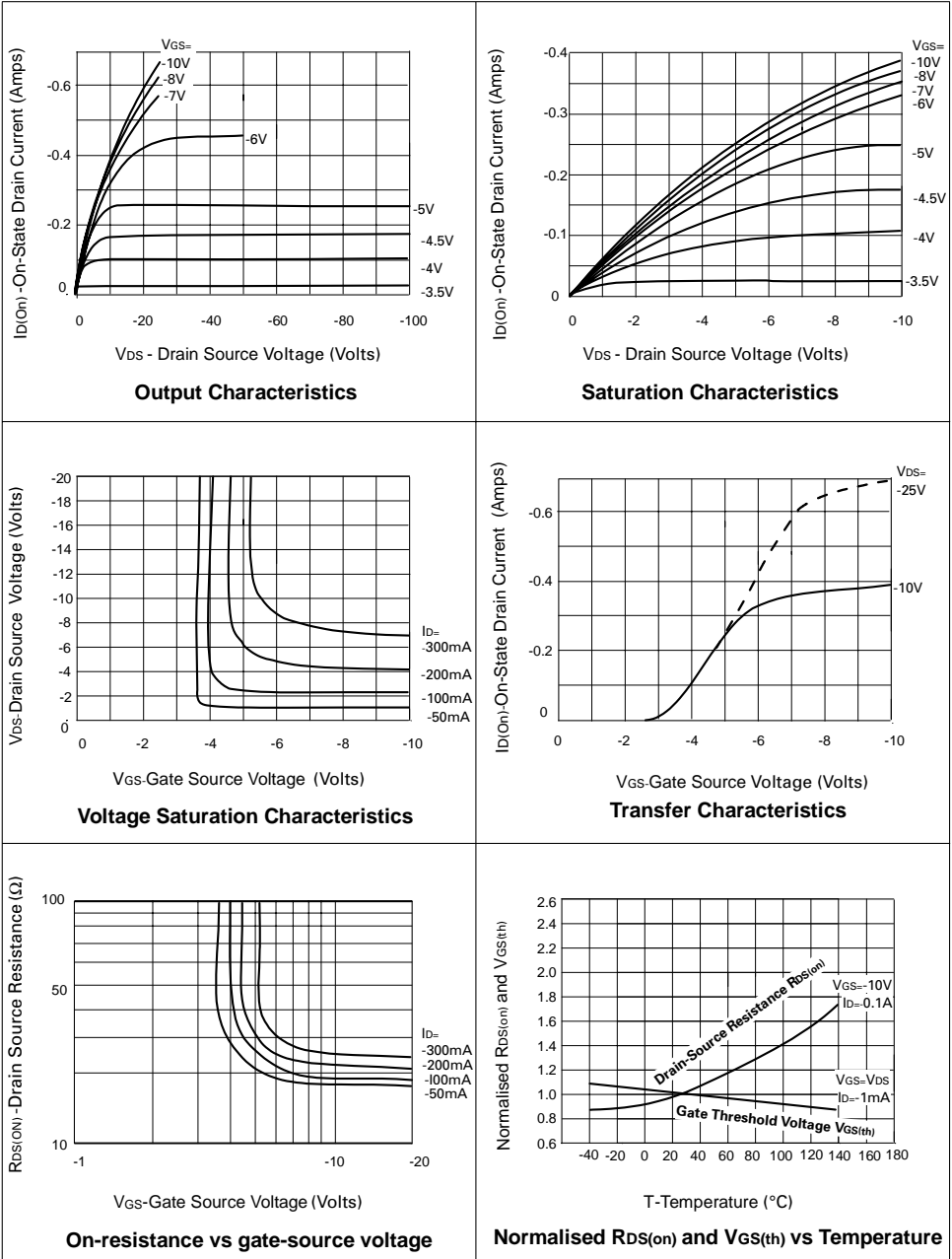
| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|---|--------------|------|-------------|--------------------|---|
| Drain-Source Breakdown Voltage | BV_{DSS} | -200 | | V | $I_D=-1mA, V_{GS}=0V$ |
| Gate-Source Threshold Voltage | $V_{GS(th)}$ | -1.5 | -3.5 | V | $I_D=-1mA, V_{DS}=V_{GS}$ |
| Gate-Body Leakage | I_{GSS} | | 20 | nA | $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$ |
| Zero Gate Voltage Drain Current | I_{DSS} | | -10 -100 | μA μA | $V_{DS}=-200V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=-160V, V_{GS}=0V,$ $T=125^{\circ}C(2)$ |
| On-State Drain Current(1) | $I_{D(on)}$ | -300 | | mA | $V_{DS}=-25V, V_{GS}=-10V$ |
| Static Drain-Source On-State Resistance (1) | $R_{DS(on)}$ | | 25 | Ω | $V_{GS}=-10V, I_D=-150mA$ |
| Forward Transconductance (1)(2) | g_{fs} | 50 | | mS | $V_{DS}=-25V, I_D=-150mA$ |
| Input Capacitance (2) | C_{iss} | | 100 | pF | $V_{DS}=-25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$ |
| Common Source Output Capacitance (2) | C_{oss} | | 25 | pF | |
| Reverse Transfer Capacitance (2) | C_{rss} | | 7 | pF | |
| Turn-On Delay Time (2)(3) | $t_{d(on)}$ | | 7 | ns | $V_{DD}=-25V, I_D=-150mA$ |
| Rise Time (2)(3) | t_r | | 15 | ns | |
| Turn-Off Delay Time (2)(3) | $t_{d(off)}$ | | 12 | ns | |
| Fall Time (2)(3) | t_f | | 15 | ns | |

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

(2) Sample test.

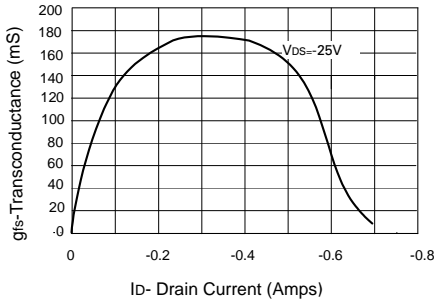
ZVP2120A

TYPICAL CHARACTERISTICS

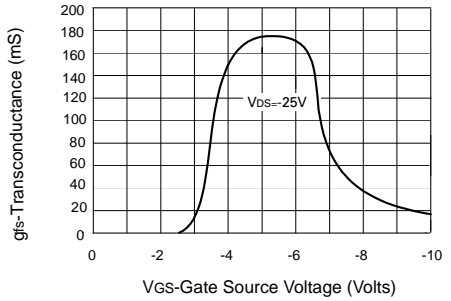


ZVP2120A

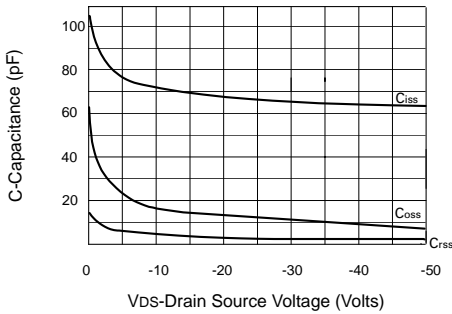
TYPICAL CHARACTERISTICS



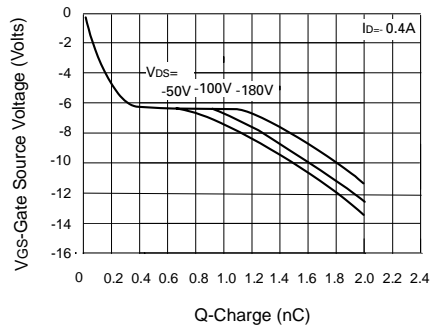
Transconductance v drain current



Transconductance v gate-source voltage



Capacitance v drain-source voltage



Gate charge v gate-source voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.